

トランジスタ

2SB709, 2SB709A

2SB709, 2SB709A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形/Si PNP Epitaxial Planar

一般増幅用/General Amplifier

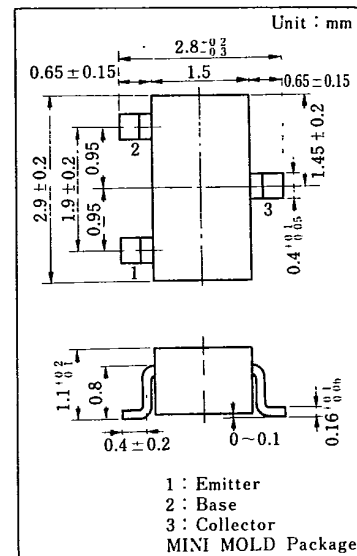
2SD601, 2SD601A とコンプリメンタリ/Complementary Pair
with 2SD601, 2SD601A

■ 特徴/Feature

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。/High h_{FE}

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	25	V
2SB709A		45	
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	25	V
2SB709A		45	
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	200	mA
コレクタ電流	$-I_C$	100	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +125$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0$			1	μA
	$-I_{CEO}$	$-V_{CE} = 10\text{ V}, I_B = 0$			100	
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C = 10\text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	25			V
2SB709A			45			
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C = 2\text{ mA}, I_B = 0$	25			V
2SB709A			45			
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E = 10\text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$-V_{CE} = 10\text{ V}, -I_C = 2\text{ mA}$	160		460	
トランジション周波数	f_T	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 1\text{ mA}$		80		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 100\text{ mA}, -I_B = 10\text{ mA}$		0.3	0.5	V
コレクタ出力容量	C_{ob}	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$		2.7		pF

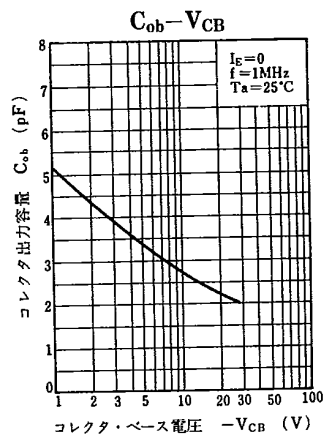
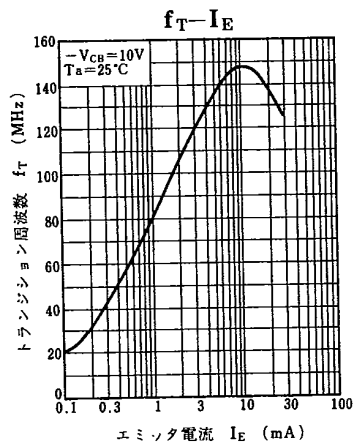
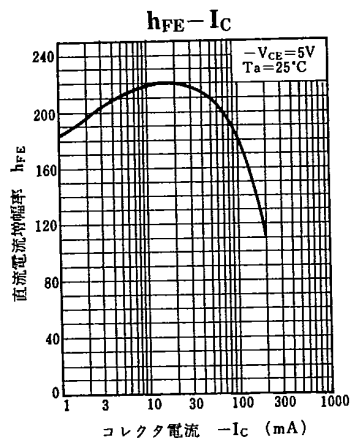
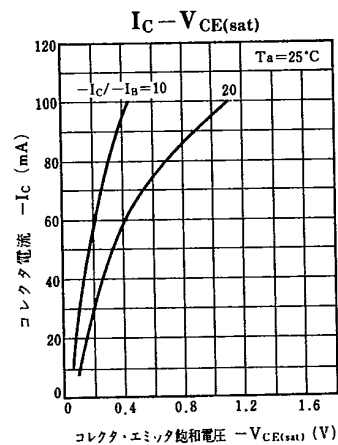
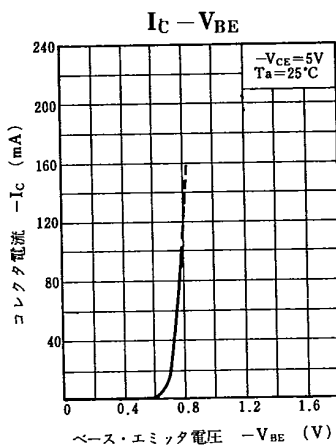
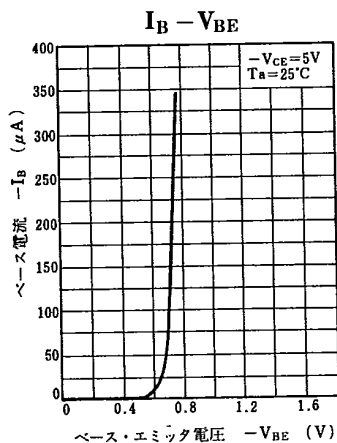
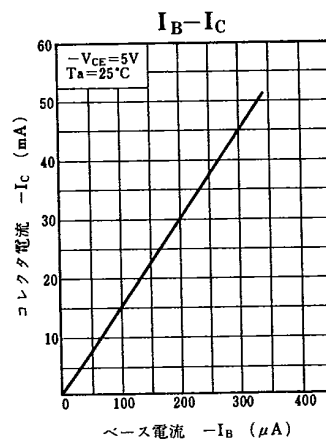
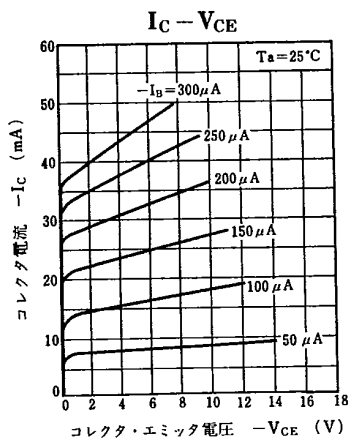
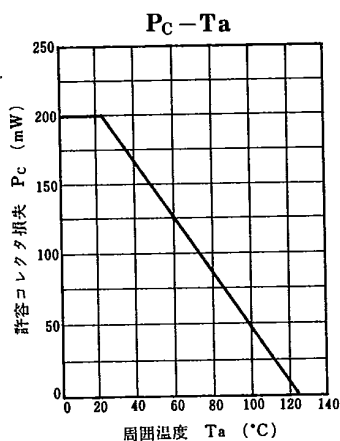
* h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

Class		Q	R	S
h _{FE}		160~260	210~340	290~460
Marking Symbol	2SB709	AQ	AR	AS
	2SB709A	BQ	BR	BS

トランジスタ

T-29-15

2SB709, 2SB709A



トランジスタ

T-29-15

2SB709, 2SB709A

